

Изделия в стадии освоения  
**Транзистор КПЕ119А9**

МДП-транзистор кремниевый эпитаксиально-планарный полевой с изолированным затвором и n-каналом, со встроенным диодом, изготовлен по trench-gate технологии, в металлополимерном корпусе для поверхностного монтажа.

Категория качества – «ОТК»

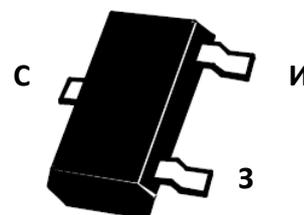
**Назначение:**

транзистор предназначен для работы в мощных импульсных источниках питания, в схемах управления электродвигателями, инверторах, прерывателях, усилителях звуковой частоты и импульсов высокой энергии.

Ближайший кремниевый функциональный аналог IRLML0030TRPbF (ф. International Rectifier).

Масса изделий не более 0,025 г.

Технические условия АДКБ.432140.564ТУ



**KT-46 (SOT-23)**

$U_{СИ} = 30 \text{ В,}$

$I_C = 3,2 \text{ А,}$

$R_{СИ} = 85 \text{ мОм}$

**Основные и предельно-допустимые значения электрических параметров транзисторов**

Наименование параметра, единица измерения (режим измерения)	Буквенное обозначение параметра	Норма параметра		Температура окружающей среды, °С
		не менее	не более	
1	2	3	4	5
Максимально допустимое постоянное напряжение сток-исток, В	$U_{СИ.мах}$		30	
Максимально допустимый постоянный ток стока, А	$I_{С.мах}$		3,2 1,5	от -60 до 40 125 ± 5
Максимально допустимое постоянное напряжение затвор-исток, В	$U_{ЗИ.мах}$		± 20	от -60 до 125
Максимально допустимая температура перехода, °С	$t_{п.мах}$		150	
Максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность, Вт			0,5	25 ± 10
Тепловое сопротивление переход-окружающая среда, °С/Вт			250	
Сопротивление сток-исток в открытом состоянии, Ом ( $U_{ЗИ} = 10 \text{ В, } I_C = 3,2 \text{ А, } \tau_{и} \leq 1 \text{ 000 мкс;}$ $U_{ЗИ} = 4,5 \text{ В, } I_C = 2,2 \text{ А, } \tau_{и} \leq 1 \text{ 000 мкс}$ )	$R_{СИ.отк}$			25 ± 10
Пороговое напряжение, В ( $U_{СИ} = U_{ЗИ}, I_C = 250 \text{ мкА}$ )	$U_{ЗИ.пор}$	1,3	2,3	25 ± 10